









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD35N10S3L26ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 35A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD35N10S3L26ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD35N10S3L26ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 35A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 39µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-11
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

IPD35N10S3L26ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD35N10S3L26ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD35N10S3L26ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD35N10S3L26ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD35N10S3L-26 I IPD35N10S3L-26 I</p>	 <p>IPD350N06LG Infineo IPD350N06LG Infineo</p>	 <p>IPD400N06NGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 27A TO-252</p>	 <p>IPD35N12S3L24ATMA1 Infineon Technologies N-CHANNEL_100+</p>
 <p>IPD350N06LGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 29A DPAK</p>	 <p>IPD40N03S4L-08 INFINEO IPD40N03S4L-08 INFINEO</p>	 <p>IPD35CN10NG INF IPD35CN10NG INF</p>	 <p>IPD400N06NG INFINEO IPD400N06NG INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD35N10S3L26ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD35N10S3L26ATMA1 Datenblatt	IPD35N10S3L26ATMA1-Datenblätter	IPD35N10S3L26ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD35N10S3L26ATMA1
IPD35N10S3L26ATMA1 Electronic	IPD35N10S3L26ATMA1-Komponenten	IPD35N10S3L26ATMA1-Verteiler	IPD35N10S3L26ATMA1-Bild	IPD35N10S3L26ATMA1-Teil
IPD35N10S3L26ATMA1 Preis	IPD35N10S3L26ATMA1 Hersteller	IPD35N10S3L26ATMA1 Bild	IPD35N10S3L26ATMA1 Aktie	IPD35N10S3L26ATMA1 Inventar
IPD35N10S3L26ATMA1 Neu	IPD35N10S3L26ATMA1 Original	IPD35N10S3L26ATMA1 garantiert	IPD35N10S3L26ATMA1 RFQ	IPD35N10S3L26ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited